

富信  
电子集团



安徽富信半导体科技有限公司  
ANHUI FOSAN SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO., LTD.

RB520CS-30

## SOD-923 Schottky Barrier Diode 肖特基势垒二极管

### ■ Internal Configuration& Device Marking 内部结构与产品打标

Type 型号	RB520CS-30		
Pin 管脚	 		
Mark 打标	E		

### ■ Absolute Maximum Ratings 最大额定值

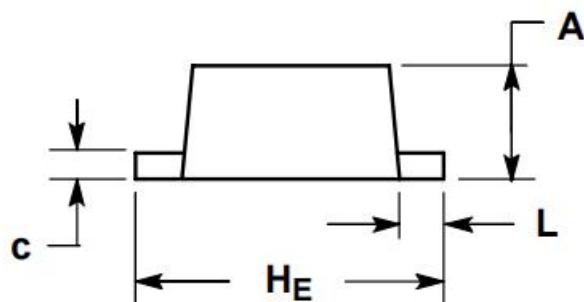
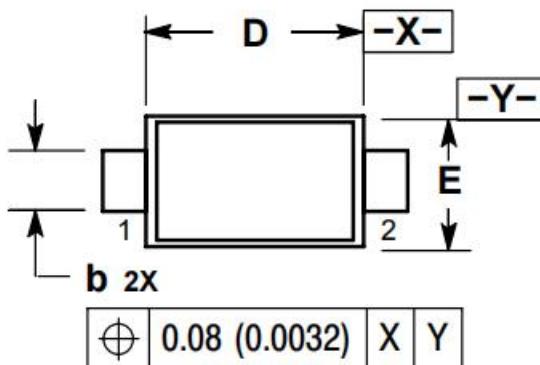
Characteristic 特性参数	Symbol 符号	Rat 额定值	Unit 单位
Repetitive Peak Reverse Voltage 重复峰值反向电压	V <sub>RRM</sub>	30	V
DC Reverse Voltage 直流反向电压	V <sub>R</sub>	30	V
Forward Work Current 正向工作电流	I <sub>o</sub>	200	mA
Peak Forward Surge Current 正向峰值浪涌电流	I <sub>FSM</sub>	1000	mA
Power dissipation 耗散功率	P <sub>D</sub> (Ta=25°C)	200	mW
Thermal Resistance J-A 结到环境热阻	R <sub>θJA</sub>	500	°C/W
Junction and Storage Temperature 结温和储藏温度	T <sub>j</sub> , T <sub>stg</sub>	-55 to +125°C	

### ■ Electrical Characteristics 电特性

(TA=25°C unless otherwise noted 如无特殊说明, 温度为 25°C)

Characteristic 特性参数	Symbol 符号	Min 最小值	Max 最大值	Unit 单位
Reverse Breakdown Voltage 反向击穿电压(IR=10μA)	V <sub>(BR)</sub>	30	—	V
Reverse Leakage Current 反向漏电流(VR=10V)	I <sub>R</sub>	—	1	μA
Forward Voltage(I <sub>F</sub> =10mA) 正向电压(I <sub>F</sub> =200mA)	V <sub>F</sub>	0.4 0.6	0.6	V

■ Dimension 外形封装尺寸



DIM	MILLIMETERS			INCHES		
	MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX
<b>A</b>	0.34	0.37	0.40	0.013	0.015	0.016
<b>b</b>	0.15	0.20	0.25	0.006	0.008	0.010
<b>c</b>	0.07	0.12	0.17	0.003	0.005	0.007
<b>D</b>	0.75	0.80	0.85	0.030	0.031	0.033
<b>E</b>	0.55	0.60	0.65	0.022	0.024	0.026
<b>H<sub>E</sub></b>	0.95	1.00	1.05	0.037	0.039	0.041
<b>L</b>	0.05	0.10	0.15	0.002	0.004	0.006